



2SB1274 (3CA1274)

硅 PNP 半导体三极管/SILICON PNP TRANSISTOR

用途：用于低频功率放大。

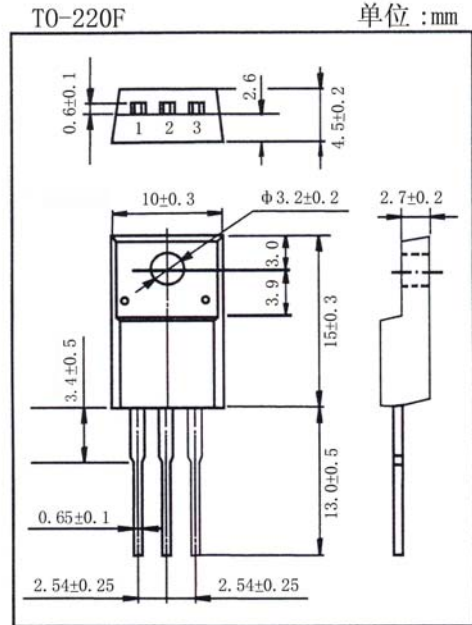
Purpose: Low frequency power amplifier applications.

特点：击穿电压高，饱和压降低，安全工作区宽。

Features: High V_{CE0} , low saturation voltage, wide ASO.

极限参数/Absolute maximum ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	-60	V
V_{CE0}	-60	V
V_{EB0}	-6.0	V
I_C	-3.0	A
I_{CP}	-8.0	A
P_C	2.0	W
$P_C(TC=25^\circ\text{C})$	25	W
T_j	150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$



引脚： 1. B 2. C 3. E

电性能参数/Electrical characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition		数值 Rating			单位 Unit
			最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CB0}	$I_C=-1.0\text{mA}$	$I_E=0$	-60			V
V_{CE0}	$I_C=-5.0\text{mA}$	$I_B=0$	-60			V
V_{EB0}	$I_E=-1.0\text{mA}$	$I_C=0$	-6.0			V
I_{CB0}	$V_{CB}=-40\text{V}$	$I_E=0$			-100	μA
I_{EB0}	$V_{EB}=-4.0\text{V}$	$I_C=0$			-100	μA
$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=-5.0\text{V}$	$I_C=-0.5\text{A}$	70		280	
$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=-5.0\text{V}$	$I_C=-3.0\text{A}$	20			
$V_{CE(sat)}$	$I_C=-3.0\text{A}$	$I_B=-0.3\text{A}$		-0.4	-1.0	V
V_{BE}	$V_{CE}=-5.0\text{V}$	$I_C=-0.5\text{A}$		-0.8	-1.0	V
f_T	$V_{CE}=-5.0\text{V}$	$I_C=-0.5\text{A}$		100		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=-10\text{V}$	$f=1.0\text{MHz}$		60		pF

$h_{FE(1)}$ 分档/ $h_{FE(1)}$ classifications: Q: 70~140 R: 100~200 S: 140~280

